

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成27年7月23日(2015.7.23)

【公表番号】特表2014-519720(P2014-519720A)

【公表日】平成26年8月14日(2014.8.14)

【年通号数】公開・登録公報2014-043

【出願番号】特願2014-515909(P2014-515909)

【国際特許分類】

H 01 L 31/0687 (2012.01)

H 01 L 31/054 (2014.01)

【F I】

H 01 L 31/06 3 1 0

H 01 L 31/04 6 2 0

【手続補正書】

【提出日】平成27年6月3日(2015.6.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

多重接合太陽電池であって、

nドープされた第1のIII～V半導体層及びpドープされた第1のIII～V半導体層を備える第1のpn接合部と、

前記第1のpn接合部の下に位置付けられる第2のpn接合部であって、nドープされた第2のIII～V半導体層及びpドープされた第2のIII～V半導体層を備える、第2のpn接合部と、

第1のpn接合部の上に位置付けられる電流拡散層であって、エピタキシャルなII～VI半導体層を備える、電流拡散層と、

前記第1のpn接合部と反対側で前記電流拡散層に位置付けられた電極と、を備える、多重接合太陽電池。

【請求項2】

集光型光起電力モジュールであって、

太陽光を集光することができる光学素子と、

多重接合太陽電池と、を備え、

前記光学素子が、入射太陽光を受光し、100sunを超える強度を有する光が前記多重接合太陽電池に入射するように、前記入射太陽光を前記多重接合太陽電池上に集束させ、

前記多重接合太陽電池が、エピタキシャルなII～V半導体のpn接合部を備え、エピタキシャルなII～VI半導体の電流拡散層をさらに備え、前記II～VI半導体の電流拡散層が、前記光学素子により集束された光が前記電流拡散層に入射するように、前記II～V半導体のpn接合部と前記光学素子との間に位置付けられる、集光型光起電力モジュール。